

091

METODOLOGIA DE CARACTERIZAÇÃO DE TRANSISTORES MOS EM TECNOLOGIA**0.35UM.** *Eduardo Conrad Junior, Alessandro Girardi, Fernando Paixão Cortes, Luciano de Paula, Sergio Bampi (orient.) (UFRGS).*

O processo de fabricação moderno de CI's necessita de modelos precisos que emulem o comportamento dos dispositivos básicos que os compõem. Dentro deste contexto, a caracterização destes dispositivos através de medidas elétricas é de fundamental importância. Um chip teste foi prototipado em tecnologia CMOS 0.35um, onde diversos transistores MOS foram implementados utilizando duas metodologias de projeto: Full-custom e associação trapezoidal de transistores (TAT). As características DC e AC dos transistores foram obtidas através de medidas experimentais, e posteriormente os parâmetros de modelos de simulação (como ACM e EKV) poderão ser obtidos a fim de se tenha modelos mais precisos. Este trabalho visa demonstrar a metodologia empregada na caracterização dos transistores, assim como o procedimento para a extração dos parâmetros dos modelos e seus resultados. (BIC).